

# 新しいIDDE技術により

## 効率と堅牢性を大幅に強化する 28V / 32V LDMOS



ゲインや効率および負荷の不整合耐性を改善した  
新しいIDDEパワーRF LDMOS技術

短い伝導チャネル長と高いブレークダウン電圧を兼ね備えたLDMOSデバイスはRFパワー・アンプに最適で、商用または産業用システムに使用できます。

STの革新的なIDDE技術は、STが対応できるアプリケーションの範囲を拡大し、優れた性能およびコスト効率を備えた競争力の高いソリューションをパワーRFの設計者に提供します。

### 特徴

- 高効率
- 低熱抵抗
- 最適化されたパワーRFパッケージ

### 利点

- 消費電力の節減
- クラス最高クラスの信頼性
- コスト効率に優れたソリューション

### アプリケーション

- 産業・科学・医療(ISM)
- 地上ベースのモバイルRF通信
- 商用 & 国防用HF/VHF/UHF無線
- エアバンド & VHF航空電子機器

## IDDE技術

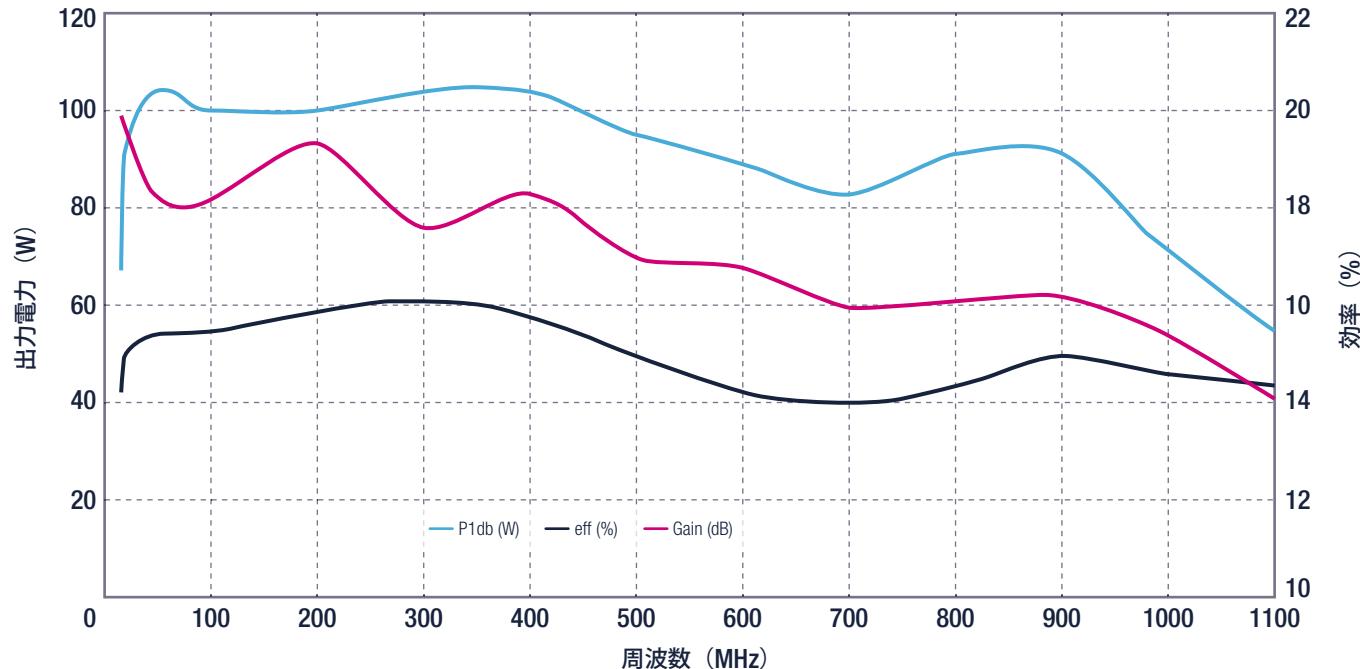
### 28V/32Vの動作電圧で最大1.5GHz

IDDEは、28V/32Vコモン・ソース、Nチャネル・エンハンスメント・モード、ラテラル電界効果、RFパワー・トランジスタ技術です。

STのIDDEポートフォリオは10W ~ 400Wの出力パワーを備え、クラスA、AB、およびCを含むすべての標準的変調フォーマットの最大

1.5GHzのプロードバンド商用、アビオニクス、および産業用機器専用に設計されています。

### ST05150の広帯域特性：電力ゲインと効率と出力電力( $V_{DD} = 28V$ )



品名	パッケージ	周波数 (MHz)	出力電力 (W)	電力ゲイン(dB)	電源電圧 (V)	効率 (%)
ST16010	MM	930	12	21	28	63
ST9045C	M243	945	63	18.5	28	70
ST9060C	M243	945	80	17	28	70
RF3L05150CB4	LBB	945	150	16	28	60
RF3L05200CB4	LBB	945	200	16	28	60
ST05250	B4E	945	250	14	28	55
RF3L05250CB4	LBB	945	250	16	28	55
RF3L05400CB4	LBB	500	380	17	28	60
RF4L10700CB4*	D4E	915	700	15	40	68
RF4L15400CB4*	D4E	1500	400	16	40	60

\* 開発中

